

**Family list**

**1 family member for:**

**JP2003258226**

Derived from 1 application.

**1 RADIATION DETECTOR AND ITS FABRICATING METHOD**

Publication Info: JP2003258226 A - 2003-09-12

---

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide/

## RADIATION DETECTOR AND ITS FABRICATING METHOD

Patent number: JP2003258226

Publication date: 2003-09-12

Inventor: MOCHIZUKI CHIORI

Applicant: CANON KK

Classification:

- International: G01T1/20; H01L21/336; H01L27/146; H01L29/786;  
H01L31/09; H04N5/32; H04N5/335; H01L31/10;  
G01T1/00; H01L21/02; H01L27/146; H01L29/66;  
H01L31/08; H04N5/32; H04N5/335; H01L31/10; (IPC1-  
7): H01L27/146; G01T1/20; H01L21/336; H01L29/786;  
H01L31/09; H01L31/10; H04N5/32; H04N5/335

- european:

Application number: JP20020051481 20020227

Priority number(s): JP20020051481 20020227

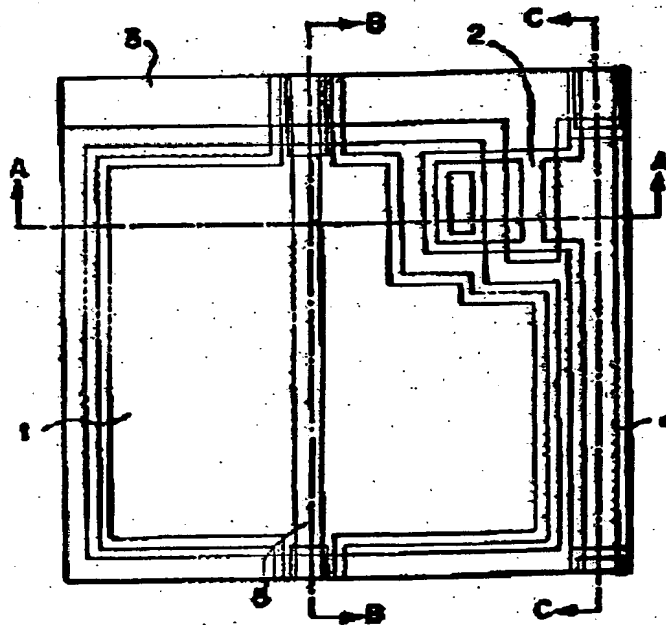
Report a data error here

## Abstract of JP2003258226

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To enhance sensitivity by enhancing the signal component and the noise components independently without having an effect on each other.

**SOLUTION:** With regard to the noise components, signal line noise and IC noise are reduced by employing a multilayer structure of a first insulation layer, a semiconductor layer, and a second insulation layer at the intersection of a signal line and a switch TFT drive line, thereby reducing parasitic capacitance at the intersection of wiring. With regard to the signal component, functions of an n<sup>+</sup> film, i.e., the hole blocking function and electrode function, are separated to the n<sup>+</sup> film and a transparent conductive film, respectively, in order to make thin the n<sup>+</sup> film, thus enhancing the incidence efficiency of light. Furthermore, performance of both a signal conversion element and the switch TFT is enhanced by making thick the semiconductor layer at the photoelectric conversion part and making thin the semiconductor layer of the switch TFT thus enhancing the sensitivity.

COPYRIGHT: (C)2003,JPO



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2003-258226

(P 2003-258226A)

(43) 公開日 平成15年9月12日(2003.9.12)

(51) Int. Cl. 7	識別記号	F I	キーワード (参考)
H01L 27/146		G01T 1/20	E 2G088
G01T 1/20			G 4M118
H01L 21/336		H04N 5/32	5C024
29/786		5/335	U 5F049
		H01L 27/14	C 5F088

審査請求 未請求 請求項の数 7 O L (全17頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2002-51481 (P 2002-51481)

(22) 出願日 平成14年2月27日(2002.2.27)

(71) 出願人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72) 発明者 望月 千織

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

(74) 代理人 100065385

弁理士 山下 稔平

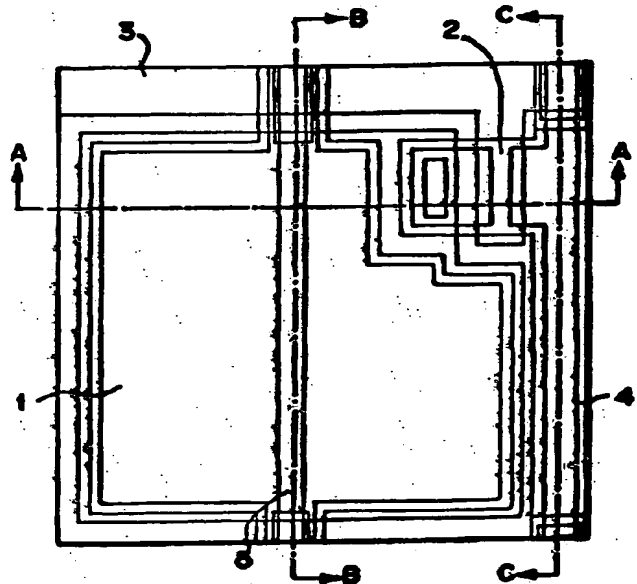
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 放射線検出装置及びその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 信号成分及びノイズ成分を夫々に影響を与えることなく、単独で向上させ、感度の向上を達成する。

【解決手段】 ノイズ成分においては、信号線とスイッチTFT駆動配線との配線交差部を第1の絶縁層、半導体層、第2の絶縁層の積層構造とすることにより、配線交差部で形成される寄生容量を低減し、信号線ノイズ、I C I Cノイズを低減する。また、信号成分においては、n'膜の機能であるホールブロッキング機能と電極機能を、夫々、n'膜と透明導電膜に機能分離させることにより、n'膜を薄膜化し、光入射効率を向上させる。また、光電変換素子部の半導体層を厚膜化し、一方、スイッチTFTの半導体層を薄膜化することにより、信号変換素子及びスイッチTFTの性能を共に向上させ、感度向上を達成する。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 放射線信号を可視光に変換する蛍光体と、前記可視光を電気信号に変換する光電変換素子と、前記光電変換素子の信号を読み出すスイッチTFTとを有する放射線検出装置において、前記信号変換素子及びスイッチTFTは、夫々同一部材の電極層、第1の絶縁層、半導体層、オーミックコンタクト層で構成され、且つ、前記光電変換素子のバイアス配線と前記スイッチTFTの駆動配線の配線交差部、或いは、前記スイッチTFTの駆動配線と信号線の配線交差部は、少なくとも、前記第1の絶縁層、半導体層、第2の絶縁層を介して形成されており、前記光電変換素子の半導体層とスイッチTFTの少なくともソース・ドレイン電極部の半導体層は、異なる膜厚で構成されていることを特徴とする放射線検出装置。

【請求項2】 前記スイッチTFTのソース・ドレイン電極部の半導体層と、前記スイッチTFTのチャネル部の半導体層及び前記光電変換素子の半導体層は、異なる膜厚で構成されていることを特徴とする請求項1に記載の放射線検出装置。

【請求項3】 前記光電変換素子の半導体層の膜厚は、前記スイッチTFTのソース・ドレイン電極部の膜厚よりも厚く形成されていることを特徴とする請求項1に記載の放射線検出装置。

【請求項4】 前記スイッチTFTのチャネル部の半導体層及び前記光電変換素子の半導体層の膜厚は、前記スイッチTFTのソース・ドレイン電極部の半導体層の膜厚よりも厚く形成されていることを特徴とする請求項2に記載の放射線検出装置。

【請求項5】 放射線信号を可視光に変換する蛍光体と、前記可視光を電気信号に変換する光電変換素子と、前記光電変換素子の信号を読み出すスイッチTFTとを有する放射線検出装置の製造方法において、

(1) 絶縁基板上に第1の金属層により前記光電変換素子の下電極、前記スイッチTFTのゲート電極、前記スイッチTFTの駆動配線を形成する工程と、

(2) 第1の絶縁層、半導体層、第2の絶縁層を順次積層する工程と、

(3) 前記光電変換素子部の第2の絶縁層を除去し、前記スイッチTFTの少なくともソース・ドレイン部の第2の絶縁層及び半導体層の一部を除去する工程と、

(4) n<sup>+</sup>型半導体層を積層する工程と、

(5) 第2の金属層により前記光電変換素子のバイアス配線及び前記スイッチTFTのソース・ドレイン電極及び信号線を形成する工程と、を含むことを特徴とする放射線検出装置の製造方法。

【請求項6】 前記(3)の工程において、前記スイッチTFTの少なくともソース・ドレイン部の半導体層の除去厚みは、前記光電変換素子部のレジスト膜厚を薄く化することで制御し、前記第2の絶縁層のみを除去する

部分と、前記第2の絶縁層と前記半導体層の一部を除去する部分を同時に加工することを特徴とする請求項5に記載の放射線検出装置の製造方法。

【請求項7】 前記(5)の工程において、更に、前記光電変換素子部に透明電極を形成することを特徴とする請求項5に記載の放射線検出装置の製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、X線、 $\gamma$ 線等の放射線を用いた放射線検出装置及びその製造方法に関し、特に、医療画像診断装置、非破壊検査装置、放射線を聞いた分析装置等に好適な放射線検出装置及びその製造方法に関するものである。

## 【0002】

【従来の技術】 液晶TFT技術の進歩、情報インフラの整備が充実した現在では、非単結晶シリコン、例えば、非晶質シリコン（以下、a-Siと略称）を用いた光電変換素子とスイッチTFTにより形成されたセンサアレイと、放射線を可視光等に変換する蛍光体とを組み合わせたフラットパネル検出器（以下、FPDと略称）が実用化され、大面積で、且つ、真のデジタル化の可能性が窺われてきている。

【0003】 このFPDは、放射線画像を瞬時に読み取り、瞬時にディスプレイ上に表示できるものであり、しかも、画像はデジタル情報として直接取り出すことが可能であるため、データの保存、或いは加工、伝送等取り扱いが便利であるといった特徴がある。また、感度の諸特性は撮影条件に依存するが、従来のS/F系撮影法、CR撮影法に比較して、同等又はそれ以上であることが確認されている。

【0004】 図25は従来のFPDの模式的等価回路図を示す。図中、101は光電変換素子、102は伝送用TFT部、103は伝送用TFT駆動部、104は信号線、105はバイアス配線、106は信号処理回路、107はTFT駆動回路、108はA/D変換部である。

【0005】 X線等の放射線は紙面上部より入射し、不図示の蛍光体により可視光に変換される。変換光は、光電変換素子101により電荷に変換され、光電変換素子101内に蓄積される。その際、TFT駆動回路107の駆動により伝送用TFT駆動部103を通じて伝送用TFT部102を動作させる。これにより、この蓄積電荷は信号線104に伝送され、信号処理回路106で処理され、更に、A/D変換部108でA/D変換され出力される。

【0006】 基本的に、上述のような素子構成が一般的であり、特に、光電変換素子としてはPIN型フォトダイオード（以下、PIN型PDと略称）、やMIS型フォトダイオード（以下、MIS型PDと略称）等様々な素子が用いられている。このMIS型PDは、本発明

10

20

30

40

50

3

明者等が特許第3066944号、USP6075256等で提案しているものである。

【0007】図26は光電変換素子をMIS型PDとした場合の1画素の模式的平面図を示す。図中201はMIS型PD部の下電極、202はスイッチTFT駆動配線、203はスイッチTFTゲート電極、204はコンタクトホール、205はセンサバイアス配線、206は信号線、207はスイッチTFTのソース・ドレイン電極（以下、SD電極と略記）である。

【0008】また、図27は図26に示す1画素内の各素子を模式的に配列した場合の模式的断面図を示す。301はガラス基板、302はスイッチTFT駆動配線、303はMIS型PD下電極、304はスイッチTFTゲート電極、305はゲート絶縁膜、306は真性a-Si膜、307はホールブロッキング層、308はバイアス配線、309は転送TFT SD電極、310は信号線、320は保護膜、321は有機樹脂層、322は蛍光体層である。

【0009】なお、図27におけるMIS型PD下電極303、スイッチTFT駆動配線302、スイッチTFTゲート電極304、バイアス配線308、スイッチTFT SD電極309、信号線310は、図26におけるMIS型PD下電極201、スイッチTFT駆動配線202、スイッチTFTゲート電極203、バイアス配線205、スイッチTFT SD電極207、信号線206にそれぞれ対応する。

【0010】ここで、図26及び図27から明らかなようにMIS型PDとスイッチTFTは層構成が同一であるため、製造方法が簡便で、高歩留り、低価格を実現できる利点がある。しかも、感度等の諸特性も十分満足できるものと評価されており、現在、一般撮影に用いられる装置としては、従来のS/F法及びCR法に代わって、上述のFPDが採用されるに至っている。

【0011】

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述のようなFPDにおいては、大面積で、且つ、完全デジタル化が実現可能で、尚く、一般撮影に主に使用され始めている状況であるが、感度といった点では、更なる向上が期待されている。また、透視撮影を可能とするためには、より一層の感度向上が必須と考えられている。

【0012】図28はMIS型PDを用いたFPDの1ピットの等価回路を示す。図中、C1はMIS型PDの合成容量、C2は信号線に形成される寄生容量、Vsはセンサバイアス電位、Vrはセンサリセット電位、SW1はMIS型PDのVs/Vr切り替えスイッチ、SW2は転送用TFT部のON/OFF切り替えスイッチ、SW3は信号線リセットスイッチ、Voutは出力電圧である。

【0013】MIS型PDにはバイアス電位として半導体層が空乏化する様にスイッチSW1により電位Vsが

4

与えられる。この状態で、蛍光体からの変換光が半導体層に入射すると、ホールブロッキング層で阻止されていた正電荷がa-Si層内に蓄積され、電位差Vtが発生する。その後、スイッチSW2よりスイッチTFTのON電圧が印加され、電圧Voutとして出力される。出力Voutは不図示の読出し回路（図25の信号処理回路106）により読み出され、その後スイッチSW3により信号線がリセットされる。

【0014】上述の駆動方法に従ってスイッチTFTを図25に示すライン毎に順次ONすることにより、1フレームの全読出しが完了する。その後、スイッチSW1よりMIS型PDにリセット電位Vrを与え、リセットを行う。また、再度、同様にバイアス電位Vsを与え、画像読み取りの蓄積動作を行う。このようにして放射線を用いての画像が得られる。

【0015】MIS型PDの出力Voutの飽和電位、概ね電位Vtに比例する。電位Vtはバイアス電位Vs-Vrと内部Gain Gの積により決まる。内部Gain Gは、 $C_{ins}/(C_{ins}+C_{sem})$ で求められる。出力電圧Voutは、概ね電位Vtに対しC1/C2容量比で出力される。また、MIS型PDの感度は、光入射状態での上述の飽和出力電圧、即ち、信号成分と、暗状態での出力電圧、即ち、ノイズ成分の比で概ね表される。

【0016】信号成分は、一般的に、(1) PD開口率、(2) PD光入射効率、言い換えれば、真性a-Si膜内に入射する光子、更に、(3) 内部Gainに依存する。一方、ノイズ成分は以下に示す様々なノイズが確信されている。

【0017】センサ開口率の平方根に比例するショットノイズ

C1容量の平方根に比例するKTCノイズ

信号配線ノイズ（配線抵抗の平方根及びC2容量に比例する配線ノイズ）

C2容量に比例するICノイズ

ゲート配線ノイズ（配線抵抗の平方根に比例するゲートノイズ）

通常、感度向上を達成するためには、当然のことながら、信号成分を増大させるか、或いは、ノイズ成分を減少させるか、或いは、それらを同時に達成される必要がある。しかし、信号成分とノイズ成分は相互に関連しており、前者を改善した結果、後者に影響を及ぼし、結局、感度改善には至らない場合が多い。

【0018】例えば、信号成分を改善するために、上述の(1) PD開口率を向上させる場合、配線間、或いは、配線間のスペースをシュリンクして、実現することが考えられるが、逆に、微細化に伴い、配線抵抗、或いは、信号線の寄生容量が増大し、ノイズ成分が増大する結果となる。即ち、信号成分は改善されるが、ノイズ成分は増加することになり、感度低下を引き起こす場合が

ある。更に、微細化により配線ルールが厳しくなるため、歩留り低下等の生産性を低下させることになる。

【0019】また、上述の(2)PDへの光入射効率においても、光電変換層であるa-Si膜に接合されているオーミックコンタクト層は、キャリアブロッキング層としての機能と上部電極としての機能を有しており、光吸収を無視できない500Å程度以上の膜厚が必要となる。その結果、n'膜での光吸収が感度低下を引き起こす。当然、n'膜の薄膜化を実施した場合、逆に、n'膜の抵抗が大きくなり、PD上部電極としての機能しない結果となる。

【0020】更に、上述の(3)内部Gainを向上させる場合、a-Si膜の厚膜化、或いは、ゲートSiN膜の薄膜化を実施する必要がある。しかし、a-Si膜の厚膜化は、一方でスイッチTFTの転送能力の低下を引き起こし、その結果、TFTサイズの増大、開口率の低下となる。また、その応力、異物発生等、生産上の問題においても限度がある。また、SiN膜の薄膜化は、配線交差部等での絶縁耐圧を考慮すると同様に限度があり、仮に、薄膜化が達成できたとしても、寄生容量C2の増大によりノイズ成分が増加し、目立った感度向上は達成できない。

【0021】一方、ノイズ低減に着目して、ゲート配線抵抗を低減する場合、ゲート配線の厚膜化、或いは、幅広化が必要であるが、前者は配線交差部での絶縁耐圧の低下を引き起こし、後者は開口率の低下を引き起こすことになる。また、信号線の配線抵抗を低減する場合、信号線の厚膜化、或いは、幅広化が必要であるが、前者は応力の増大により生産設備上限度があるばかりか、加工上の問題から厚膜化は限度がある。また、後者は上述と同様に開口率の低下を引き起こす。

【0022】以上の説明から明らかなように、現行の構成では、設計において感度は最適化することは可能であるが、感度の向上には限界があった。そのため、より一層の感度を向上するには、根本的な構成、或いは製造プロセスの改良が必要であった。

【0023】本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたもので、その目的は、信号成分、ノイズ成分を夫々に影響を与えることなく改善でき、より感度を向上することが可能な放射線検出装置及びその製造方法を提供することにある。

【0024】

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達成するため、放射線信号を可視光に変換する蛍光体と、前記可視光を電気信号に変換する光電変換素子と、前記光電変換素子の信号を読み出すスイッチTFTとを有する放射線検出装置において、前記信号変換素子及びスイッチTFTは、夫々同一部材の電極層、第1の絶縁層、半導体層、オーミックコンタクト層で構成され、且つ、前記光電変換素子のバイアス配線と前記スイッチTFT

の駆動配線の配線交差部、或いは、前記スイッチTFTの駆動配線と信号線の配線交差部は、少なくとも、前記第1の絶縁層、半導体層、第2の絶縁層を介して構成されており、前記信号変換素子の半導体層とスイッチTFTの少なくともソース・ドレイン電極部の半導体層は、異なる膜厚で構成されていることを特徴とする。

【0025】また、本発明は、放射線信号を可視光に変換する蛍光体と、前記可視光を電気信号に変換する光電変換素子と、前記光電変換素子の信号を読み出すスイッチTFTとを有する放射線検出装置の製造方法において、(1)絶縁基板上に第1の金属層により前記光電変換素子の下電極、前記スイッチTFTのゲート電極、前記スイッチTFTの駆動配線を形成する工程と、(2)第1の絶縁層、半導体層、第2の絶縁層を順次積層する工程と、(3)前記光電変換素子部の第2の絶縁層を除去し、前記スイッチTFTの少なくともソース・ドレイン部の第2の絶縁層及び半導体層の一部を除去する工程と、(4)n'型半導体層を積層する工程と、(5)第2の金属層により前記光電変換素子のバイアス配線及び前記スイッチTFTのソース・ドレイン電極及び信号線を形成する工程と、を含むことを特徴とする。

【0026】本発明では、ノイズ成分において、信号線とスイッチTFT駆動配線との配線交差部を第1の絶縁層、半導体層、第2の絶縁層の積層構造とすることにより、配線交差部で形成される寄生容量C2を低減でき、信号線ノイズ、ICノイズを低減することができる。更に、信号成分において、n'膜の機能であるキャリアブロッキング機能と電極機能を、夫々、n+膜と透明導電膜に機能分離することにより、n'膜を薄膜化し、光入射効率を向上することが可能となる。また、信号変換素子部の半導体層を厚膜化し、一方、スイッチTFTの半導体層を薄膜化することにより、信号変換素子及びスイッチTFTの性能を共に向上でき、感度の向上を達成できる。

【0027】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。

【0028】(第1の実施形態) 図1は本発明のMIS型PDを用いた放射線検出装置の第1の実施形態を示す模式的平面図である。なお、図1では1画素の構成を示す。また、ここでは、放射線としてX線を用いているが、α線、γ線等を用いてもよい。これは、以下の実施形態でも同様である。図1において、1はMIS型PD部、2はスイッチTFT、3はスイッチTFT駆動配線、4は信号線、5はバイアス配線である。

【0029】ここで、図1では1画素の構成を示しているが、実際には、図25に示すように図1の画素が2次元に複数配列され、且つ、図25と同様にTFT駆動配線103、信号線104、バイアス配線105、信号線処理回路106、TFT駆動回路107、A/D変換器1

08、後述する放射線を可視光に変換する蛍光体等を用いて放射線検出装置が構成される。これは、以下の実施形態でも同様である。なお、図1における1画素の等価回路は図28と同様であり、これは以下の実施形態でも同様である。

【0030】X線は上述の蛍光体（図示せず）により可視光に変換され、MIS型PD部1に入射する。入射光はMIS型PD部1で光電変換され、PD部1内に蓄積される。その後、スイッチTFT駆動配線3からON電圧が印加され、スイッチTFT部2をON状態とすることにより信号線4を介して出力電圧が読み出される。その後、バイアス配線5からリセット電圧がMIS型PD部1に印加され、PD部1に蓄積された電荷をリセットする。

【0031】図2は図1のA-A線における模式的断面図、図3は図1のB-B線における模式的断面図、図4は図1のC-C線における模式的断面図を示す。図中10はガラス基板（絶縁基板）、11はMIS型PDの下電極、12はスイッチTFTゲート電極、13はスイッチTFT駆動配線、14は第1の絶縁膜、15は半導体層、16は第2の絶縁膜、17はオーミックコンタクト層、18はコンタクトホール、19はバイアス配線、20は信号線、21はスイッチTFT SD電極、30は保護層、31は有機樹脂層、32は蛍光体層である。なお、図2～図4におけるスイッチTFT駆動配線13、バイアス配線19、信号線20は、図1におけるスイッチTFT駆動配線3、バイアス配線5、信号線4にそれぞれ対応する。

【0032】ここで、図1～図4から明らかなようにスイッチTFT駆動配線13とバイアス配線19との交差部、及びスイッチTFT駆動配線13と信号線20との交差部は、第1の絶縁膜14、半導体層15、第2の絶縁膜16を介して構成されている。この結果、信号線の寄生容量を低減することができる。本願発明者の実験によれば、信号線の寄生容量であるC2容量を15～20%程度低減できることを確認した。また、寄生容量を低減できるので、ICノイズ、信号線ノイズを単独で改善することができる。更に、ゲート線の寄生容量に起因すると考えられているクロストークも同様に低減することが可能である。

【0033】また、図2に示すようにスイッチTFT部2の半導体層15、特に、スイッチTFT SD電極21下の半導体層15が薄膜化されているため、従来、スイッチTFT SD電極下に形成される直列抵抗がON抵抗を増大させていたが、スイッチTFT SD電極21下の半導体層15を薄膜化することにより、TFT伝送能力を向上させ、小型TFTを実現することが可能である。概略ではあるが、 $W/L$ で半分に縮小可能である。このことは、PD部の開口率を向上させ、一方、光電変換素子の半導体層を厚膜化できるため、信号成分を

大きく改善できる。

【0034】次に、本実施形態の製造方法を図2～図4、図5(a)～図5(d)、図6(a)～図6(c)を参照して説明する。なお、図5、図6は1画素の構成を示す。本実施形態では以下の工程で製造を行う。

【0035】(1) まず、ガラス基板10上に第1の金属層として、Al-Nd薄膜2500Å、Mo薄膜300Åの積層膜をスパッター装置により成膜する。

【0036】(2) ウエットエッチングを用いたフォトリソグラフィ法によりスイッチTFT駆動配線13、スイッチTFTのゲート電極12、及びMIS型PD部1の下電極11をパターン形成する。図5(a)はこの場合の模式的平面図を示す。

【0037】(3) 第1の絶縁膜14としてSiN、半導体層15としてa-Si、第2の絶縁膜16としてSiN層をプラズマCVD装置により、夫々2500Å、8000Å、2000Å成膜する（図2～図4(c)）。

【0038】(4) 次に、RIE或いはCDEを用いたフォトリソグラフィ法により、スイッチTFT駆動配線13とバイアス配線19の交差部42、及びMIS型PD部1の下電極11とバイアス配線19の交差部43、及び信号線20とスイッチTFT駆動配線13の交差部45以外の第2の絶縁膜16を除去する。また、コンタクトホール18の第2の絶縁膜も除去される。図5(b)はこの場合の模式的平面図を示す。

【0039】(5) RIE或いはCDEを用いたフォトリソグラフィ法により、スイッチTFT SD電極21を包括した島状領域48の半導体層15を5000Å程度除去する。図5(c)はこの場合の模式的平面図を示す。

【0040】この場合、(4)の工程と(5)の工程を入れ替える事も可能である。このように工程を入れ替えると、最初の(5)の工程では島状領域48の第2の絶縁膜16を除去し、次の(4)の工程で各交差部42、43、45以外の第2の絶縁膜16と島状領域48のa-Si層（半導体層）を除去することになる。

【0041】(6) オーミックコンタクト層17としてn層をプラズマCVD装置により1000Å成膜する。

【0042】(7) RIE或いはCDEを用いたフォトリソグラフィ法によりコンタクトホール18を形成する。図5(d)はこの場合の模式的平面図を示す。この時、コンタクトホール18は、良好なテーパ形状を実現するため、(4)の工程で第2の絶縁膜を除去し、

(5)の工程でa-Si層の一部を除去し、第1の絶縁膜14、薄膜化されたa-Si層、n層をエッチングする構成としている。

【0043】(8) 第2の金属層として、Mo薄膜500Å、Al薄膜1μm、Mo薄膜300Åをスパッター

装置により成膜する。

【0044】(9) ウエットエッチングを用いたフォトリソグラフィー法により、バイアス配線19をパターン形成する。図6(a)はこの場合の模式的平面図を示す。この時、レジストパターンは、同時にスイッチTFT SD電極21、及び信号線20が形成される領域は夫々のパターンを包括する島状領域46として残す。

【0045】(10) 再度、ウエットエッチングを用いたフォトリソグラフィー法によりスイッチTFT SD電極21、信号線20をパターン形成する。引き続いて、同一レジストパターンでRIEを用いてn'膜を除去する。図6(b)はこの場合の模式的平面図を示す。この時、レジストパターンは同時にMIS型PD部の上電極となる領域、及びバイアス線19を包括する領域を島状領域47として残す。なお、(9)の工程と(10)の工程は入れ替えが可能である。

【0046】(11) RIE或いはCDEを用いたフォトリソグラフィー法により第1の絶縁膜14、a-Si膜を除去し、素子間分離を行う。図6(c)はこの場合の模式的平面図を示す。この時、第1の絶縁膜14は必ずしも除去する必要はなく、a-Si膜のみを除去するだけでも十分である。また、この素子間分離に関して、第1の絶縁膜14、a-Si膜を一括して除去する様にMIS型PD部の上部電極となるn'膜パターンを素子間分離領域内に配置しているが、第1の絶縁膜14、a-Si膜、n'膜を一括して除去する様にすることも、上述の(10)の工程において島状領域47を素子間分離領域外に配置することで可能である。

【0047】(12) 保護層30として、SiN膜2500ÅをプラズマCVD装置により成膜する。

【0048】(13) RIE或いはCDEを用いたフォトリソグラフィー法により、配線引き出し部等を露出させる。

【0049】(14) 蛍光体層32を有機樹脂31等で張り合わせる。以上により、本実施形態の放射線検出装置が完成する。

【0050】(第2の実施形態) 次に、本発明の第2の実施形態について説明する。第2の実施形態は、第1の実施形態の製造方法を簡略化したものである。具体的には、第1の実施形態の(4)の工程と(5)の工程を同時に処理することにより、製造工程を簡略化するものである。なお、放射線検出装置の構成は図1～図4の第1の実施形態と同様である。以下、本実施形態の製造方法について説明する。

【0051】まず、(1)の工程から(3)の工程は第1の実施形態と同様である。その後、RIE或いはCDEを用いたフォトリソグラフィー法によりスイッチTFT駆動配線13とバイアス配線19の交差部42、及びMIS型PD部の下電極11とバイアス配線19の交差部43、及び信号線20とスイッチTFT駆動配線13

交差部45以外の第2の絶縁膜16を除去すると共に、スイッチTFT SD電極21を包括した島状領域48の半導体層15を5000Å程度除去する。

【0052】図7はこの場合の1画素の模式的平面図、図8は図7のA-A線における模式的断面を示す。特に、図8はRIE或いはCDE加工時の様子を示す。図中、51はレジストである。レジスト51としてはハーフトーンマスク或いはそれに類似したマスクが用いられ、膜厚T1、T2部を形成する。ドライエッチング中にレジスト51がT2分の膜減りを起こすと、該当部分がエッチングされ始める。

【0053】即ち、膜厚T2部の第2の絶縁膜16を除去する間に、レジスト開口部はT2膜減り相当の時間でa-Si層がエッチングされることになる。そこで、T2膜厚をエッチング条件に合わせて選択することにより、所望のa-Si層の除去膜厚を設計できる。その後、第1の実施形態の(6)の工程に戻り、以降は第1の実施形態と同様の処理を行う。この結果、第1の実施形態の(4)の工程と(5)の工程が一括処理で実現可能となり、工程数を削減でき、それに伴い歩留りを向上できるので、低価格化をも実現できる。

【0054】(第3の実施形態) 次に、本発明の第3の実施形態について説明する。第3の実施形態では、更に、感度を向上することが可能な放射線検出装置の形について説明する。図9は本実施形態の模式的平面図である。図9は1画素の構成を示す。図中1はMIS型PD部、2はスイッチTFT部、3はスイッチTFTの駆動配線、4は信号線、5はバイアス配線である。

【0055】図10は図9のA-A線における模式的断面図を示す。図中10はガラス基板(絶縁基)、11はMIS型PD部1の下電極、12はスイッチTFTのゲート電極、14は第1の絶縁膜、15は半導体、17はオーミックコンタクト、18はコンタクトホール、19はバイアス配線、20は信号線、21はスイッチTFT SD電極、22は透明導電膜、30は保護層、31は有機樹脂、32は蛍光体である。なお、図10におけるバイアス配線19、信号線20は、図9におけるバイアス配線5、信号線4にそれぞれ対応する。

【0056】ここで、本実施形態では、スイッチTFT駆動配線13とバイアス配線19との交差部、及びスイッチTFT駆動配線13と信号線20との交差部は、第1の実施形態と同様に第1の絶縁膜14、半導体15、第2の絶縁膜16を介して形成されている。この結果、信号線の寄生容量であるC2容量を15～20%程度低減することができ、ICノイズ、信号線ノイズを単独で低減できる。

【0057】また、透明導電膜22をオーミックコンタクト17上に形成しているので、オーミックコンタクト17の機能であるホールプロッキング機能と電極



能を、夫々、 $n'$ 膜と透明導電膜22に機能分離することができ、 $n'$ 膜を薄膜化することが可能である。そのため、オーミックコンタクト層17での光吸収を低減でき、信号成分の10%以上の向上、即ち、感度の向上を達成することができる。

【0058】また、スイッチTFT部2の半導体層15、特にスイッチTFT SD電極21下の半導体層15が薄膜化されているため、従来、スイッチTFT SD電極下に形成される直列抵抗がON抵抗を増大させいたが、スイッチTFT SD電極下の半導体層15を薄膜化することによりTFT転送能力が向上し、小型TFTの実現が可能となる。概略ではあるが、スイッチTFTを $W/L$ で半分に縮小可能である。このことは、PD部の開口率を向上させ、一方、信号変換素子の半導体層15を厚膜化できるため、信号成分を大きく改善できる。

【0059】次に、本実施形態の製造方法を図10～図11、図5～図6を参照して説明する。本実施形態では、以下の工程で製造を行う。

【0060】(1) まず、ガラス基板10上に第1の金属層として、Al-Nd薄膜2500Å、Mo薄膜300Åの積層膜をスパッター装置により成膜する。

【0061】(2) ウエットエッチングを用いたフォトリソグラフィ法により、スイッチTFT駆動用配線13、スイッチTFTゲート電極12、及びMIS型PD部の下電極11をパターン形成する(図5(a)参照)。

【0062】(3) 第1の絶縁膜14としてSiN層、半導体層15として $a-Si$ 膜、第2の絶縁膜16としてSiN層をプラズマCVD装置により夫々2500Å、8000Å、2000Å成膜する。

【0063】(4) RIE或いはCDEを用いたフォトリソグラフィ法によりスイッチTFT駆動配線13とバイアス配線19の交差部42、及びMIS型PDの下電極21とバイアス配線19の交差部43、及び信号線20とスイッチTFT駆動配線13の交差部45以外の第2の絶縁膜16を除去する(図5(b)参照)。

【0064】(5) RIE或いはCDEを用いたフォトリソグラフィ法によりスイッチTFT SD電極21を包括した島状領域48の半導体層15を5000Å程度除去する(図5(c)参照)。この場合、(4)の工程と(5)の工程を入れ替えてもよい。このように工程を入れ替えると、最初の(5)の工程では島状領域48の第2の絶縁膜を除去し、次の(4)の工程で各交差部42、43、45以外の第2の絶縁膜と島状領域48の $a-Si$ 層を除去する事になる。

【0065】(6) オーミックコンタクト層17として、 $n'$ 層をプラズマCVD装置により300Å成膜する。

【0066】(7) RIE或いはCDEを用いたフォトリソグラフィ法によりコンタクトホール18を形成す

る(図5(d)参照)。この時、コンタクトホール18は、良好なテーパ形状を実現するため、(4)の工程で第2の絶縁膜を除去し、(5)の工程で $a-Si$ 層の一部を除去し、第1の絶縁膜、薄膜化された $a-Si$ 層、 $n'$ 層をエッチングする構成としている。

【0067】(8) 第2の金属層として、Mo薄膜500Å、Al薄膜1 $\mu m$ 、Mo薄膜300Åをスパッター装置により成膜する。

【0068】(9) ウエットエッチングを用いたフォトリソグラフィ法によりバイアス配線19をパターン形成する(図6(a)参照)。この時、レジストパターンは、同時にスイッチTFTのSD電極21、及び信号線20が形成される領域は、夫々のパターンを包括する島状領域46として残す。

【0069】(10) MIS型PD部の上部電極として、ITO薄膜400Åをスパッター装置により成膜する。

【0070】(11) ウエットエッチングを用いたフォトリソグラフィ法によりMIS型PD部の透明導電膜(上部電極)22を形成する。図11はこの場合の1例の模式的平面図を示す。

【0071】(12) 再度、ウエットエッチングを用いたフォトリソグラフィ法によりスイッチTFT SD電極21、信号線20をパターン形成する。引き続いて、同一レジストパターンでRIEを用いて $n'$ 膜を除去する(図6(b)参照)。この時、レジストパターンは、同時にMIS型PDの上電極となる領域、及びバイアス線19を包括する領域を島状領域47として残す。

【0072】(13) RIE或いはCDEを用いたフォトリソグラフィ法により、第1の絶縁膜、 $a-Si$ 層を除去し、素子間分離を行う(図6(c)参照)。この時、第1の絶縁膜は必ずしも除去する必要は無く、 $a-Si$ 膜のみを除去するだけでも十分である。この素子間分離に因して、第1の絶縁膜、 $a-Si$ 層を一括して除去する様にMIS型PD部の上部電極となる $n'$ 膜パターンを素子間分離領域内に配置しているが、第1の絶縁膜、 $a-Si$ 層、 $n'$ 膜を一括して除去すること、上述の(10)の工程において、島状領域47を素子間分離領域外に配置することで可能である。

【0073】(14) 保護層30として、SiN層2500ÅをプラズマCVD装置により成膜する。

【0074】(15) RIE或いはCDEを用いたフォトリソグラフィ法により、配線引き出し部等を露出させる。

【0075】(16) 蛍光体層32を接着剤(有機樹脂31)等で張り合わせる。以上により本実施形態の放電線検出装置が完成する。

【0076】なお、本実施形態の製造方法は、以下の様な様々な変形が可能である。例えば、(9)の工程に引き続いて(12)の工程、(10)の工程、(11)

の工程の順に入れ替えることが原理的に可能である。また、この際、上述の順序において(9)の工程と(12)の工程を入れ替えることも可能である。

【0077】更に、(7)の工程に引き続いて(10)の工程、(11)の工程、(8)の工程、(9)の工程、(12)の工程の順にも入れ替えることもでき、この時、同様に(9)の工程と(12)の工程を入れ替えることも可能である。また、(6)の工程に引き続いて(10)の工程、(11)の工程、更に(7)の工程、(8)の工程、(9)の工程、(12)の工程の順に入れ替えることもでき、この時、同様に(9)の工程と(12)の工程を入れ替えることも可能である。

【0078】また、(8)の工程に引き続いて(9)の工程のバイアス配線19の形成と、(12)の工程のスイッチTFT SD電極21の形成、信号線20の形成を一度に行い、その後、スイッチTFTのチャネル部のn<sup>+</sup>膜を除去し、その後、(10)の工程と(11)の工程を流動させる事により同様に製造可能である。この時、(10)の工程、(11)の工程は、(8)の工程の前に処理する事も可能である。

【0079】上述の様に本実施形態は、製造装置及び製造プロセスの個性を考慮して、工程入れ替え等の変更が可能である。

【0080】(第4の実施形態)次に、本発明の第4の実施形態について説明する。第4の本実施形態では、更に、感度向上を実現するMIS型PDを用いた放射線検出装置について説明する。図12は本実施形態の模式的平面図である。図12は1画素の構成を示す。図中1はMIS型PD部、2はスイッチTFT部、3はスイッチTFTの駆動配線、4は信号線、5はバイアス配線である。

【0081】図13は図12のA-A線における模式的断面図、図14は図1のB-B線における模式的断面図、図15は図1のC-C線における模式的断面図を示す。図中10はガラス基板(絶縁基板)、11はMIS型PD部の下電極、12はスイッチTFTゲート電極、13はスイッチTFT駆動配線、14は第1の絶縁膜、15は半導体層、16は第2の絶縁膜、17はオーミックコンタクト層、18はコンタクトホール、19はバイアス配線、20は信号線、21はスイッチTFT SD電極、30は保護層、31は有機樹脂層、32は蛍光体層である。なお、図13～図15におけるスイッチTFT駆動配線13、バイアス配線19、信号線20は、図12におけるスイッチTFTの駆動配線3、バイアス配線5、信号線4にそれぞれ対応する。

【0082】本実施形態では、スイッチTFT駆動配線13とバイアス配線19との交差部、及びスイッチTFT駆動配線13と信号線20との交差部は、第1の絶縁膜14、半導体層15、第2の絶縁膜16を介して構成されている。この結果、信号線の寄生容量であるC2容

量を15～20%程度低減でき、ICノイズ、信号線ノイズを単独で低減できる。

【0083】また、スイッチTFT部の半導体層15、特にスイッチTFT SD電極21下の半導体層15が薄膜化されているため、従来、スイッチTFT SD電極下に形成される直列抵抗がON抵抗を増大させていたが、スイッチTFT SD電極下の半導体層15が薄膜化されることにより、TFT転送能力を向上でき、小型TFTの実現が可能となる。概略ではあるが、W/Lで半分に縮小可能である。このことは、PD部の開口率を向上でき、一方、信号交換素子の半導体層15を厚膜化できるため、信号成分を大きく改善できる。

【0084】更に、後述する製造方法からも明かな様にスイッチTFTのチャネル部が、真空を破らず形成されるため、従来のエッチングにより形成されるスイッチTFTに比較して、TFT特性、即ち、閾値電圧、ON、OFF抵抗の均一性を向上できる。例えば、閾値電圧のバラツキが±1.5V以上あったものが±1.0V程度に改善でき、その結果、ON/OFF電圧のマージンを低減でき、低消費電力化が可能となる。

【0085】次に、本実施形態の製造方法を図13～図15、図16～図17を参照して説明する。図16～図17は1画素の構成を示す。本実施形態では、以下の工程で製造を行う。

【0086】(1)まず、ガラス基板10上に第1の全層膜として、Al-Nd薄膜2500Å、Mo薄膜300Åの積層膜をスパッター装置により成膜する。

【0087】(2)ウェットエッチングを用いたフォトリソグラフィー法によりスイッチTFT駆動配線13、スイッチTFT電極12、及びMIS型PD部の下電極11をパターン形成する。図16(a)はこの場合の模式的平面図を示す。

【0088】(3)第1の絶縁膜14としてSiN、半導体層15としてa-Si、第1の絶縁膜16としてSiN層をプラズマCVD装置によりそれぞれ2500Å、8000Å、2000Å成膜する。

【0089】(4)RIE或いはCDEを用いたフォトリソグラフィー法によりスイッチTFTのチャネル部41、及びスイッチTFT駆動配線13とバイアス配線19の交差部42、及びMIS型PD部の下電極11とバイアス配線19の交差部43、及び20信号線とスイッチTFT駆動配線13の交差部45以外の第2の絶縁膜を除去する。図16(b)はこの場合の模式的平面図を示す。

【0090】(5)RIE或いはCDEを用いたフォトリソグラフィー法により、スイッチTFT SD電極21を包括した領域48の半導体層15を5000Å程度除去する。図16(c)はこの場合の模式的平面図を示す。この時、(4)の工程と(5)の工程を入れ替える事が可能である。このように工程を入れ替えると、最初

の(5)の工程では島状領域48の第2の絶縁膜を除去し、次の(4)の工程で各交差部42、43、45以外の第2の絶縁膜と島状領域48のa-Si層を除去する事になる。

【0091】(6)オーミックコンタクト層17として、n'層をプラズマCVD装置により1000Å成膜する。

【0092】(7)RIE或いはCDEを用いたフォトリソグラフィ法によりコンタクトホール18を形成する。図16(d)はこの場合の模式的平面図を示す。この時、コンタクトホール18は、良好なテーパー形状を

実現するため、(4)の工程で第2の絶縁膜を除去し、(5)の工程でa-Si層の一部を除去し、結局、第1の絶縁膜、薄膜化されたa-Si層、n'層をエッチングする。

【0093】(8)第2の金属層として、Mo薄膜500Å、Al薄膜1μm、Mo薄膜300Åをスパッター装置により成膜する。

【0094】(9)ウェットエッチングを用いたフォトリソグラフィ法により、バイアス配線19をパターン形成する。図17(a)はこの場合の模式的平面図を示す。この時、レジストパターンは、同時にスイッチTFT SD電極21、及び信号線20が形成される領域は、夫々のパターンを包括する島状領域46として残す。

【0095】(10)再度、ウェットエッチングを用いたフォトリソグラフィ法により、スイッチTFT SD電極21、信号線20をパターン形成する。引き続いて、同一レジストパターンでRIEを用いてn'膜を除去する。図17(b)はこの場合の模式的平面図を示す。この時、レジストパターンは、同時にMIS型PD部の上電極となる領域、及びバイアス線19を包括する島状領域47として残す。なお、(9)の工程と(10)の工程は、単純に入れ替えることが可能である。

【0096】(11)RIE或いはCDEを用いたフォトリソグラフィ法により、第1の絶縁膜14、a-Si層を除去し、素子間分離を行う。図17(c)はこの場合の模式的平面図を示す。この時、第1の絶縁膜14は必ずしも除去する必要はなく、a-Si膜のみを除去するだけでも十分である。

【0097】(12)保護層30として、SiN膜2500ÅをプラズマCVD装置により成膜する。

【0098】(13)RIE或いはCDEを用いたフォトリソグラフィ法により、配線引き出し部等を露出させる。

【0099】(14)蛍光体層32を接着剤(有機樹脂層31)等で張り合わせる。以上により本実施形態の放射線検出装置が完成する。

【0100】(第5の実施形態)次に、本発明の第5の実施形態について説明する。第5の実施形態では、第4

の実施形態の製造方法を簡略化することが可能な形態について説明する。具体的には、第4の実施形態の(4)の工程と(5)の工程を同時に処理する事により製造工程を簡略化することが可能である。図18は本実施形態の模式的平面図を示す。なお、図18は1画面の構成を示す。図中1はMIS型PD部、2はスイッチTFT部、3はスイッチTFTの駆動配線、4は信号線、5はバイアス配線である。

【0101】図19は図18のA-A線における模式的断面図を示す。図中、10はガラス基板(絶縁基板)、11はMIS型PD部の下電極、12はスイッチTFTゲート電極、13はスイッチTFT駆動配線、14は第1の絶縁膜、15は半導体層、16は第2の絶縁膜、17はオーミックコンタクト層、18はコンタクトホール、19はバイアス配線、20は信号線、21はスイッチTFT SD電極、30は保護層、31は有機樹脂層、32は蛍光体層である。なお、図19におけるスイッチTFT駆動配線13、バイアス配線19、信号線20は、図18におけるスイッチTFTの駆動配線3、バイアス配線5、信号線4にそれぞれ対応する。

【0102】ここで、図19から明らかなようにスイッチTFTのチャネル部において、第2の絶縁膜16と半導体層15の一部が、第4の実施形態の図13に示すように段差を有しておらず、同一マスクを用いて同一工程でエッチングされた形状を示している。これは、チャネル長を微細化する上では、望ましい構造である。即ち、マスクの重ね合せ精度に必要なマージンが削除されるためである。

【0103】次に、本実施形態の製造方法について説明する。まず、(1)の工程から(3)の工程は第4の実施形態と同様である。その後、RIE或いはCDEを用いたフォトリソグラフィ法により、スイッチTFT駆動配線13とバイアス配線19の交差部42、及びMIS型PD部の下電極11とバイアス配線19の交差部43、及び信号線20とスイッチTFT駆動配線13の交差部45以外の第2の絶縁膜を除去すると共に、スイッチTFT SD電極21を包括した島状領域48の半導体層15を5000Å程度除去する。

【0104】図20はこの場合の1画面の模式的平面図を示す。また、図21は図20のA-A線における模式的断面図を示す。なお、図21はRIE或いはCDE加工時の様子を示す。図中、51はレジストである。レジスト51としてはハーフトーンマスク或いはそれに類似したマスクが用いられ、膜厚T1、T2部を形成する。ドライエッチング中にレジストがT2分の膜厚を越えると、該当部分がエッチングし始める。

【0105】即ち、膜厚T2部の第2の絶縁膜を除去する間に、レジスト開口部はT2膜厚に相当の時間でa-Si層がエッチングされることになる。そこで、T2膜厚をエッチング条件に合わせて選択する事により所望のa-

S1層の除去膜厚を設計できる。その後、第4の実施形態の(6)の工程に戻り、以降は第4の実施形態と同様の処理を行う。この結果、第4の実施形態の(4)の工程と(5)の工程が一括処理で実現可能となり、工程数を削減でき、それに伴い歩留りを向上でき、低価格化をも達成できる。

【0106】(第6の実施形態)次に、本発明の第6の実施形態について説明する。第6の実施形態では、更に、感度向上を実現可能なMIS型PDを用いた放射線検出装置について説明する。図22は本実施形態の模式的平面図である。図22は1画素の構成を示す。図中1はMIS型PD部、2はスイッチTFT部、3はスイッチTFTの駆動配線、4は信号線、5はバイアス配線である。

【0107】図23は図22のA-A線における模式的断面図を示す。図中10はガラス基板(絶縁基板)、11はMIS型PD部の下電極、12はスイッチTFTゲート電極、14は第1の絶縁膜、15は半導体層、17はオーミックコンタクト層、18はコンタクトホール、19はバイアス配線、20は信号線、21はスイッチTFT SD電極、22は透明導電膜、30は保護層、31は有機樹脂層、32は蛍光体層である。なお、図23におけるバイアス配線19、信号線20、図22におけるバイアス配線5、信号線4にそれぞれ対応する。

【0108】本実施形態では、スイッチTFT駆動配線13とバイアス配線19との交差部、及びスイッチTFT駆動配線13と信号線20との交差部は、第4の実施形態と同様に第1の絶縁膜14、半導体層15、第2の絶縁膜16を介して構成されている。この結果、信号線の寄生容量であるC2容量を15~20%程度低減でき、ICノイズ、信号線ノイズを単独で低減できる。

【0109】また、透明導電膜22をオーミックコンタクト層17上に形成しているため、オーミックコンタクト層17の機能であるホールブロッキング機能と電極機能を、夫々、n'膜と透明導電膜22に機能分離することができる。そのため、n'膜を薄膜化することが可能となり、オーミックコンタクト層17での光吸収を低減でき、信号成分の10%以上の向上、即ち、感度の向上を達成することができる。

【0110】また、スイッチTFT部の半導体層15、特に、スイッチTFT SD電極21下の半導体層15が薄膜化されているため、従来、スイッチTFT SD電極下に形成される直列抵抗がON抵抗を増大させていたが、スイッチTFT SD電極下の半導体層15が薄膜化されることにより、TFT転送能力を向上でき、小型TFTの実現が可能となる。概略ではあるが、W/Lで半分に縮小可能である。このことは、PD部の開口率を向上でき、一方、信号変換素子の半導体層を厚膜化することができるため、信号成分を大きく改善できる。

【0111】更に、スイッチTFTのチャネル部が、

空を破らず形成されるため、従来のエッチングにより形成されるTFTに比較して、TFT特性、即ち、閾値電圧、ON、OFF抵抗の均一性を向上できる。例えば、閾値電圧のバラツキが±1.5V以上あったものが、±1.0V程度に改善でき、その結果、ON/OFF電圧のマージンを低減でき、低消費電力化が可能となる。

【0112】次に、本実施形態の製造方法を図23、図24、図16~図17を参照して説明する。本実施形態では、以下の工程で製造を行う。

【0113】(1)まず、ガラス基板10上に第1の金属層として、Al-Nd薄膜2500Å、Mo薄膜300Åの積層膜をスパッター装置により成膜する。

【0114】(2)ウェットエッチングを用いたフォトリソグラフィ法により、スイッチTFT駆動配線13、スイッチTFTゲート電極12、及びMIS型PD部の下電極11をパターン形成する(図16(a)参照)。

【0115】(3)第1の絶縁膜14としてSiN、半導体層15としてa-Si、第2の絶縁膜16としてSiN層をプラズマCVD装置により、夫々2500Å、8000Å、2000Å成膜する。

【0116】(4)RIE或いはCDEを用いたフォトリソグラフィ法により、スイッチTFTのチャネル部41、及びスイッチTFT駆動配線13とバイアス配線19の交差部42、及びMIS型PD部の下電極11とバイアス配線19の交差部43、及び信号線20とスイッチTFT駆動配線13の交差部45以外の第2の絶縁膜を除去する(図16(b)参照)。

【0117】(5)RIE或いはCDEを用いたフォトリソグラフィ法により、スイッチTFT SD電極21を包括した領域48の半導体層15を500Å程度除去する(図16(c)参照)。この時、(4)の工程と(5)の工程を入れ替えてもよい。このように工程を入れ替えると、最初の(5)の工程で島状領域48の第2の絶縁膜を除去し、次の(4)の工程で各交差部42、43、45以外の第2の絶縁膜と島状領域48のa-Si層を除去するようになる。

【0118】(6)オーミックコンタクト層17として、n'層をプラズマCVD装置により300Å成膜する。

【0119】(7)RIE或いはCDEを用いたフォトリソグラフィ法によりコンタクトホール18を形成する(図16(d)参照)。この時、コンタクトホール18は、良好なテーパ形状を実現するため、(4)の工程で第2の絶縁膜を除去し、(5)の工程でa-Siの一部を除去し、結局、第1の絶縁膜、薄膜化されたa-Si、n'層をエッチングする。

【0120】(8)第2の金属層として、Mo薄膜500Å、Al薄膜1μm、Mo薄膜300Åをスパッター装置により成膜する。

【0121】(9) ウエットエッチングを用いたフォトリソグラフィ法により、バイアス配線19をパターン形成する(図17(a)参照)。この時、レジストパターンは、同時にスイッチTFT SD電極21及び信号線20が形成される領域は夫々のパターンを包括する島状領域46として残す。

【0122】(10) MIS型PD部の上部電極として、ITO薄膜400Åをスパッター装置により成膜する。

【0123】(11) ウエットエッチングを用いたフォトリソグラフィ法により、MIS型PD部の透明導電膜(上部電極)22を形成する。図24はこの場合の模式的平面図を示す。

【0124】(12) 再度、ウエットエッチングを用いたフォトリソグラフィ法により、スイッチTFT SD電極21、信号線20をパターン形成する。引き続いて、同一レジストパターンでRIEを用いてn'膜を除去する(図17(b)参照)。この時、レジストパターンは、同時にMIS型PDの上電極となる領域及びバイアス線19を包括する領域を島状領域47として残す。

【0125】(13) RIE或いはCDEを用いたフォトリソグラフィ法により、第1の絶縁膜、a-Si膜を除去し、素子間分離を行う(図17(c)参照)。この時、第1の絶縁膜は必ずしも除去する必要はなく、a-Si膜のみを除去するだけでも十分である。

【0126】(14) 保護層30として、SiN膜2500ÅをプラズマCVD装置により成膜する。

【0127】(15) RIE或いはCDEを用いたフォトリソグラフィ法により、配線引き出し部等を露出させる。

【0128】(16) 蛍光体層32を接着剤(有機樹脂層31)等で張り合わせる。以上により本実施形態の放射線検出装置が完成する。

【0129】なお、本実施形態の製造方法は、以下のような様々な変形が可能である。例えば、(9)の工程に引き続いて(12)の工程、(10)の工程、(11)の工程の順に入れ替えることが原理的に可能である。また、この際、上述の順序において(9)の工程と(12)の工程を入れ替えることも可能である。

【0130】更に、(7)の工程に引き続いて(10)の工程、(11)の工程、(8)の工程、(9)の工程、(12)の工程の順にも入れ替えることもでき、この時、同様に(9)の工程と(12)の工程を入れ替えることも可能である。また、(6)の工程に引き続いて、(10)の工程、(11)の工程、更に、(7)の工程、(8)の工程、(9)の工程、(12)の工程の順に入れ替えることもでき、この時、同様に(9)の工程と(12)の工程を入れ替えることも可能である。

【0131】また、(8)の工程に引き続いて(9)の工程のバイアス配線19の形成と、(12)の工程のス

イッチTFT SD電極21の形成、信号線20の形成を一度に行い、その後、スイッチTFTのチャネル部のn'膜を除去し、その後、(10)の工程と(11)の工程を流動させる事により、同様に製造可能である。この時、(10)の工程、(11)の工程は、(8)の工程の前に処理する事も可能である。

【0132】上述の様に本実施形態は、製造装置及び製造プロセスの個性を考慮して、工程入れ替え等の変更が可能である。

【0133】

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、信号線とスイッチTFT駆動配線との配線交差部を第1の絶縁層、半導体層、第2の絶縁層の積層構造とすることにより、配線交差部で形成される寄生容量を低減でき、信号線ノイズ、ICノイズを低減できる。更にn'膜の機能であるホールブロッキング機能と電極機能を、夫々、n'膜と透明導電膜に機能分離することにより、n'膜を薄膜化でき、光入射効率を向上できる。即ち、偏光成分、ノイズ成分を夫々に影響を与えることなく、単独で向上でき、感度の向上を達成できる。

【0134】また、MIS型PDとスイッチTFTを第1の絶縁層、半導体層、第2の絶縁層の積層構造から、簡便に製造可能であり、特に、MIS型PDの半導体層とスイッチTFTの半導体層の膜厚をPD部は厚膜化でき、TFT部は薄膜化できるため、高感度なFPDを実現できる。更に、スイッチTFTは、チャネル部を安定に製造できるため、低価格、高歩留まり、更には、低消費電力化FPDの実現と云った効果があつた。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態を示す模式的平面図である。

【図2】図1のA-A線における模式的断面図である。

【図3】図1のB-B線における模式的断面図である。

【図4】図1のC-C線における模式的断面図である。

【図5】図1の実施形態の製造方法を説明する図である。

【図6】図1の実施形態の製造方法を説明する図である。

【図7】本発明の第2の実施形態の製造方法を説明するための図である。

【図8】図6のA-A線における模式的断面図である。

【図9】本発明の第3の実施形態を示す模式的平面図である。

【図10】図9のA-A線における模式的断面図である。

【図11】第3の実施形態の製造方法を説明するための図である。

【図12】本発明の第4の実施形態を示す模式的平面図である。

【図13】図12のA-A線における模式的断面図である。

る。

【図14】図12のB-B線における模式的断面図である。

【図15】図12のC-C線における模式的断面図である。

【図16】第4の実施形態の製造方法を説明する図である。

【図17】第4の実施形態の製造方法を説明する図である。

【図18】本発明の第5の実施形態を示す模式的平面図 10 である。

【図19】図18のA-A線における模式的断面図である。

【図20】第5の実施形態の製造方法を説明するための図である。

【図21】図20のA-A線における模式的断面図である。

【図22】本発明の第6の実施形態を示す模式的断面図である。

【図23】図22のA-A線における模式的断面図であ 20 る。

【図24】第6の実施形態の製造方法を説明するための図である。

【図25】従来のFPDを示す等価回路図である。

【図26】従来のMIS型PDを用いた場合の1画素の模式的平面図である。

【図27】図26の模式的断面図である。

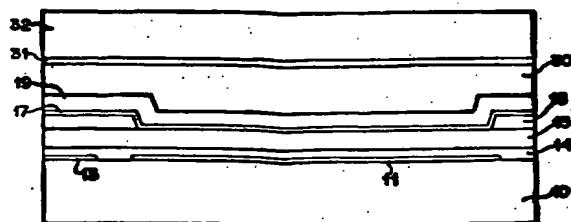
【図28】従来のMIS型PDを用いた場合の1ピットの等価回路図である。

【符号の説明】

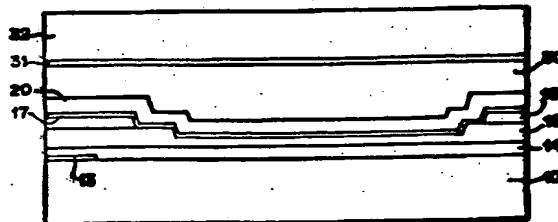
- 1 MIS型PD部
- 2 スイッチTFT部
- 3 スイッチTFTの駆動配線
- 4 信号線
- 5 バイアス配線
- 10 ガラス基板
- 11 MIS型PDの下電極
- 12 スイッチTFTゲート電極
- 13 スイッチTFT駆動配線
- 14 第1の絶縁膜

- 15 半導体層
- 16 第2の絶縁層
- 17 オーミックコンタクト層
- 18 コンタクトホール
- 19 バイアス配線
- 20 信号線
- 21 スイッチTFT SD電極
- 22 透明導電膜
- 30 保護層
- 31 有機樹脂層
- 32 蛍光体層
- 41 スイッチTFTチャネル部
- 42 スイッチTFT駆動配線とバイアス配線の交差部
- 43 MIS型PDの下電極とバイアス配線の交差部
- 44 信号線部
- 45 信号線とスイッチTFT駆動配線の交差部
- 46 スイッチTFT SD電極と信号線の領域
- 47 バイアス配線とMIS型PDの上電極部の領域
- 48 スイッチTFT SD電極の領域
- 51 レジスト
- 101 光電変換素子部
- 102 スイッチTFT部
- 103 スイッチTFT駆動配線
- 104 信号線
- 105 バイアス配線
- 106 信号処理回路
- 107 TFT駆動回路
- 108 A/D変換部
- 30 C1 MIS型PDの合成容量
- C2 信号線に形成される寄生容量
- Vs センサバイアス電位
- Vr センサリセット電位
- SW1 MIS型PDのVs/Vr切り替えスイッチ
- SW2 転送TFTのON/OFF切り替えスイッチ
- SW3 信号線リセットスイッチ
- Vout 出力電圧
- Vt 電位差
- T1、T2 レジスト膜厚

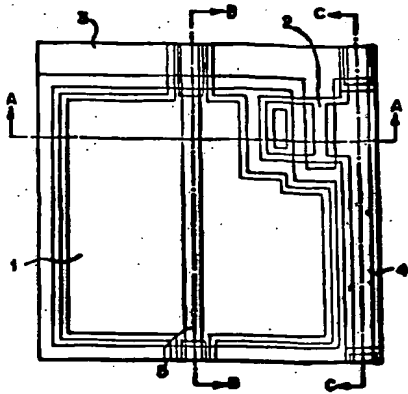
【図3】



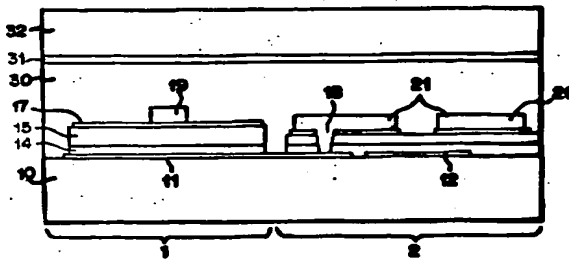
【図4】



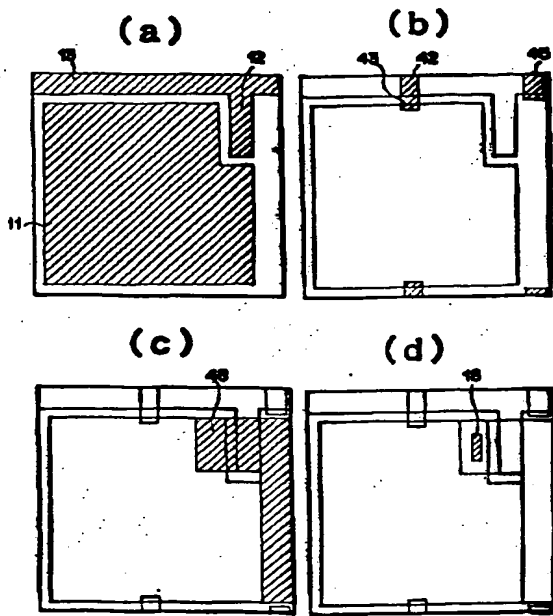
【図1】



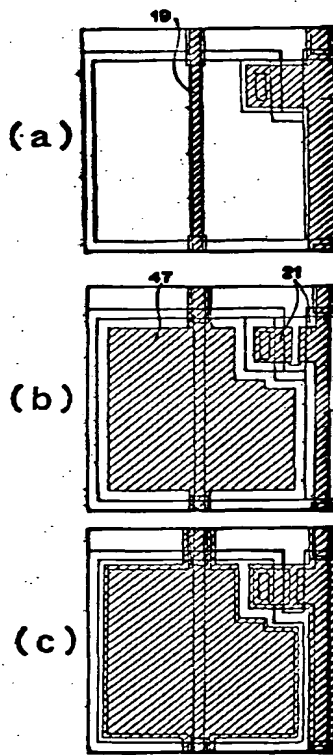
【図2】



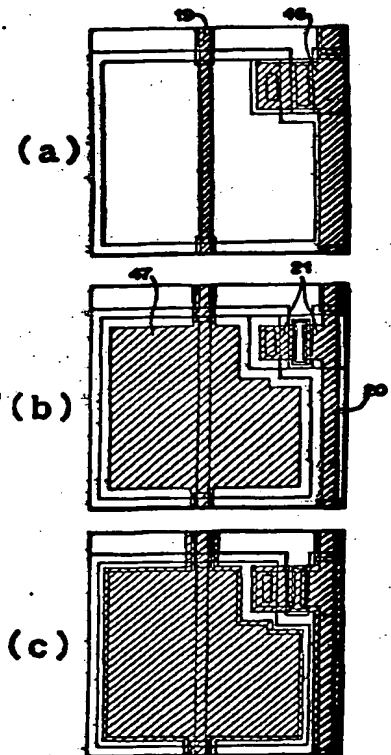
【図5】



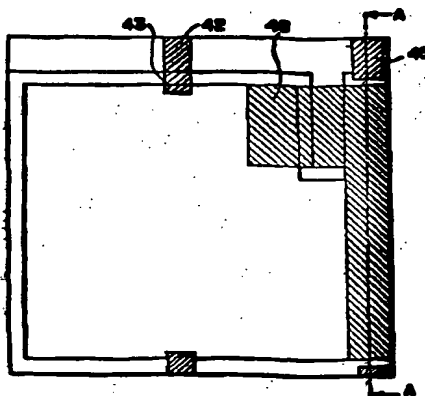
【図6】



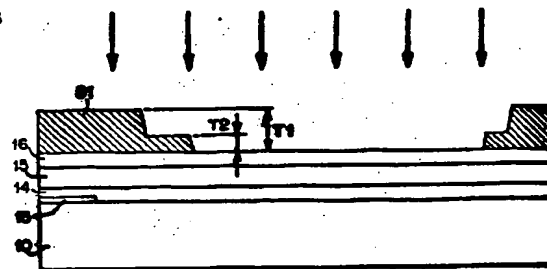
【図17】



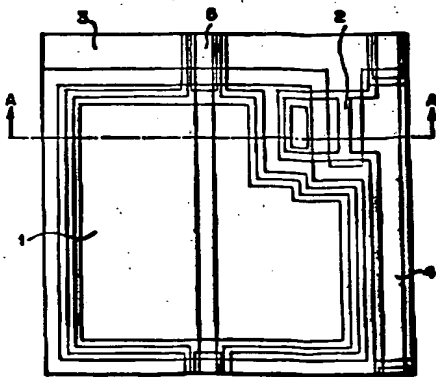
【図7】



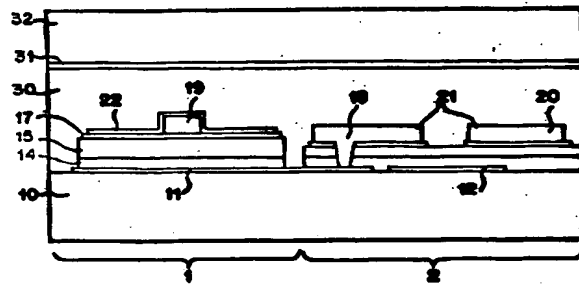
【図8】



【図9】

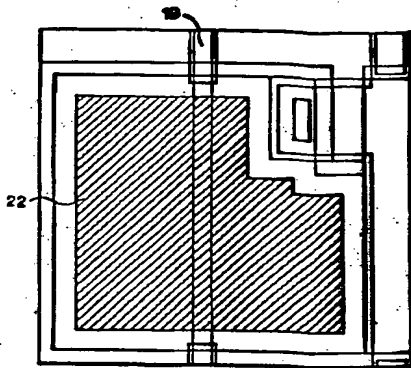


【図10】

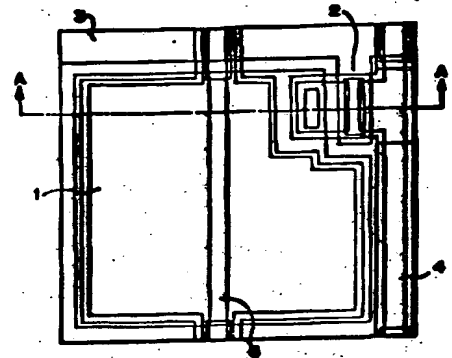
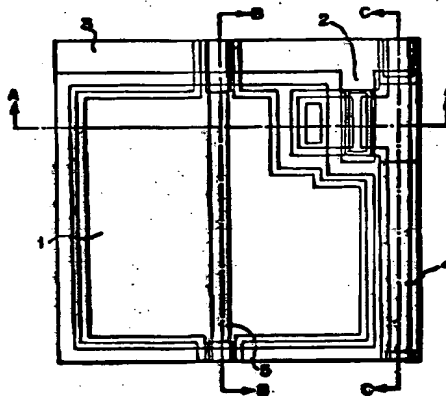


【図18】

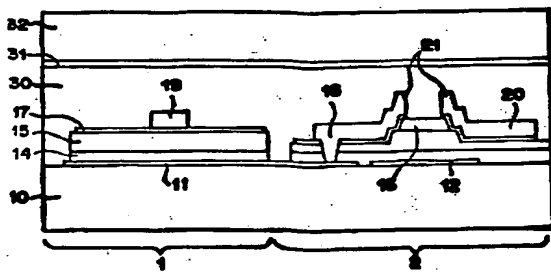
【図11】



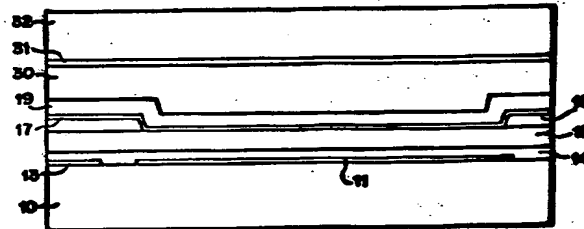
【図12】



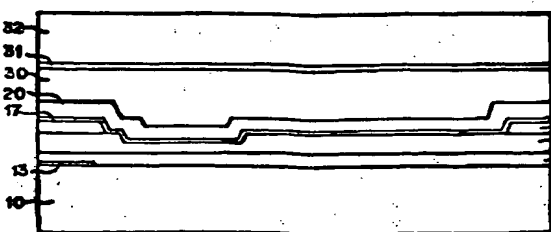
【図13】



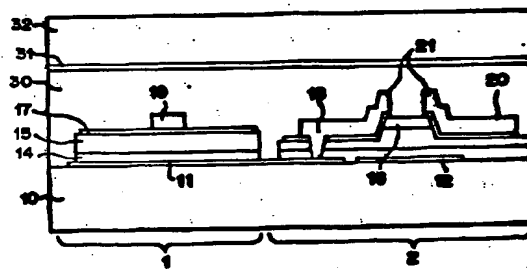
【図14】



【図15】

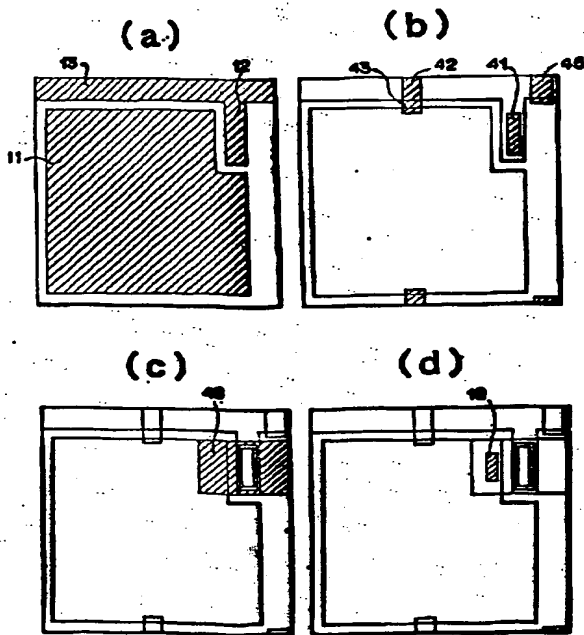


【図19】

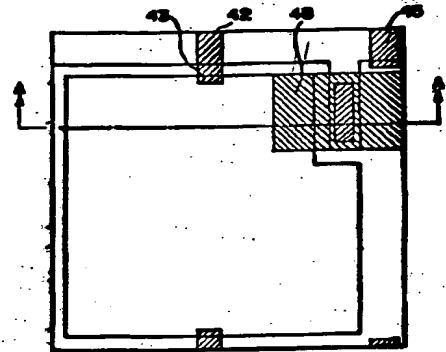




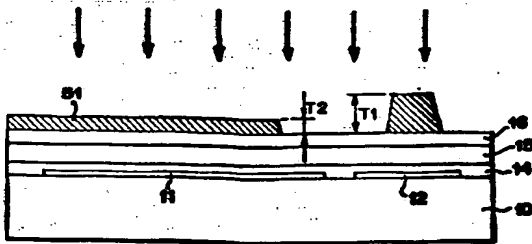
【図16】



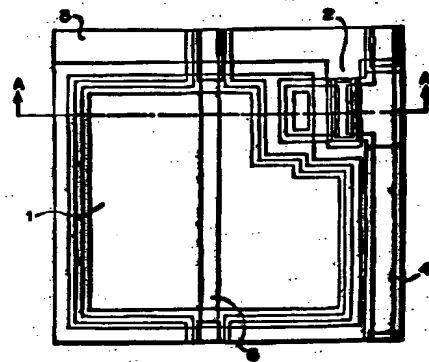
【図20】



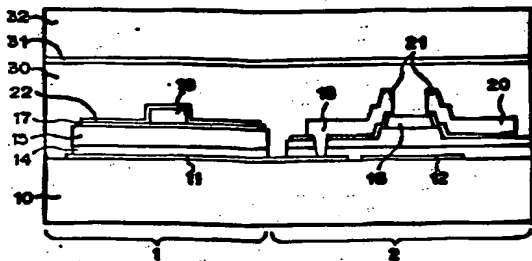
【図21】



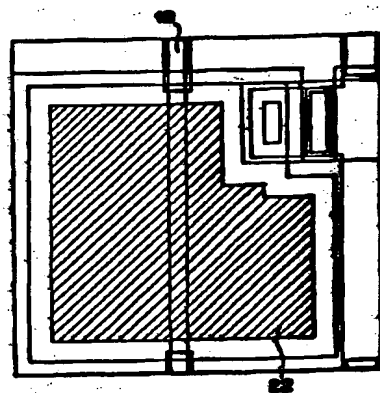
【図22】



【図23】

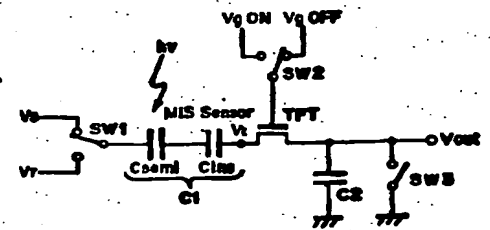
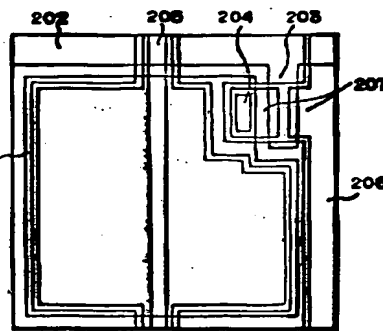


【図24】



【圖 2 6】

**【圖 28】**



This cross-sectional view shows a substrate 301 with a trench 302. A layer 303 is formed on the bottom of the trench. A gate structure 304 is formed on the side of the trench. A layer 305 is formed on the top of the gate structure. A layer 306 is formed on the top of the layer 305. A layer 307 is formed on the top of the layer 306. A layer 308 is formed on the top of the layer 307. A layer 309 is formed on the top of the layer 308. A layer 310 is formed on the top of the layer 309. A layer 311 is formed on the top of the layer 310. A layer 312 is formed on the top of the layer 311. A layer 313 is formed on the top of the layer 312. A layer 314 is formed on the top of the layer 313. A layer 315 is formed on the top of the layer 314. A layer 316 is formed on the top of the layer 315. A layer 317 is formed on the top of the layer 316. A layer 318 is formed on the top of the layer 317. A layer 319 is formed on the top of the layer 318. A layer 320 is formed on the top of the layer 319. A layer 321 is formed on the top of the layer 320. A layer 322 is formed on the top of the layer 321.

(51) Int. Cl.:

**FI**

テマコード(参考)

**H O 1 L 31/10**

**A 5 F 1 1 0**

3.1/00

**A**

**29/78**

**6 1 2-D**

100

Fターム(参考) 2G088 EE01 EE29 FF02 FF04 GG19  
JJ05 JJ32 JJ33 JJ37 LL11  
LL12 LL15  
4M118 AB01 BA05 CA02 FB03 FB13  
FB16  
5C024 AX12 AX16 CX03 CY47 GX03  
5F049 MA01 MB05 NA01 NA04 NA15  
NB05 RA04 RA08 SS01 SZ20  
UA01 UA07 UA14 WA97  
5F088 AA01 AB05 BA01 BA03 BB03  
BB07 EA04 EA08 EA14 EA16  
GA02 HA15 HA20 KA03 KA08  
KA10 LA07  
5F110 AA30 BB09 CC07 DD02 EE04  
EE06 EE14 FF03 FF30 GG02  
GG15 GG24 GG45 HK03 HK04  
HK09 HK22 HK33 HK35 NN04  
NN24 NN35 NN71